

2SA539

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ／PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用／Audio Frequency Amplifier

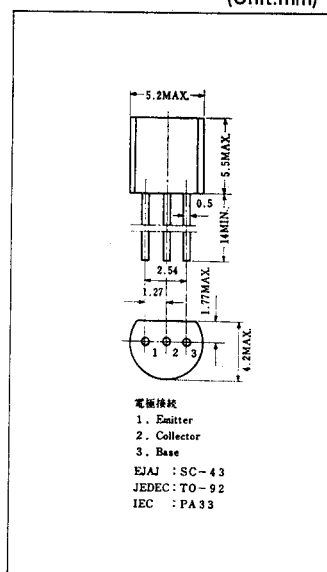
特 徴／FEATURES

- ・主要特性は NPN 形の 2SC815 とほとんど同じであり、2SC815 とコンプリメンタリで使用可能です。
- ・10Wクラスアンプのドライバに最適です。
- ・高耐圧です。
- ・High voltage : $V_{CBO} = -60V$, $V_{CEO} = -45V$
- ・Complementary to NPN 2SC815.

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-45	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V
コレクタ電流	I_C	-200	mA
全損失	P_T	250	mW
ジャンクション温度	T_J	125	$^{\circ}C$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^{\circ}C$

外形図／PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -45V$, $I_E = 0$			-0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3.0V$, $I_C = 0$			-0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -1.0V$, $I_C = -50mA^*$	50	80	232	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -2.0V$, $I_C = -150mA^*$	30	70		
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -10V$, $I_C = -10mA$	-0.60	-0.65	-0.90	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -150mA$, $I_B = -15mA^*$		-0.25	-0.50	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -150mA$, $I_B = -15mA^*$		-0.9	-1.2	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -10V$, $I_E = 10mA$		150		MHz

*パルス測定／Pulsed

h_{FE} 区分／ h_{FE} Classification

h_{FE1} / M : 50~94 L : 80~150 K : 125~232